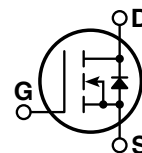
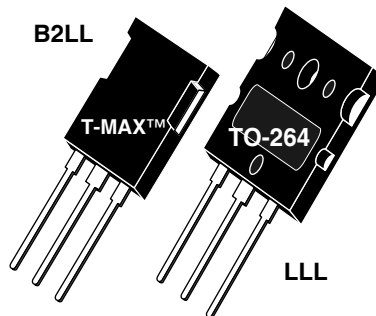


## POWER MOS 7® MOSFET

Power MOS 7® is a new generation of low loss, high voltage, N-Channel enhancement mode power MOSFETS. Both conduction and switching losses are addressed with Power MOS 7® by significantly lowering  $R_{DS(ON)}$  and  $Q_g$ . Power MOS 7® combines lower conduction and switching losses along with exceptionally fast switching speeds inherent with APT's patented metal gate structure.



- Lower Input Capacitance
- Lower Miller Capacitance
- Lower Gate Charge,  $Q_g$
- Increased Power Dissipation
- Easier To Drive
- Popular T-MAX™ or TO-264 Package

### MAXIMUM RATINGS

All Ratings:  $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APT5010B2LL_LLL	UNIT
$V_{DSS}$	Drain-Source Voltage	500	Volts
$I_D$	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	46	Amps
$I_{DM}$	Pulsed Drain Current <sup>①</sup>	184	
$V_{GS}$	Gate-Source Voltage Continuous	$\pm 30$	Volts
$V_{GSM}$	Gate-Source Voltage Transient	$\pm 40$	
$P_D$	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	520	Watts
	Linear Derating Factor	4.0	W/ $^\circ\text{C}$
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
$T_L$	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
$I_{AR}$	Avalanche Current <sup>①</sup> (Repetitive and Non-Repetitive)	50	Amps
$E_{AR}$	Repetitive Avalanche Energy <sup>①</sup>	50	mJ
$E_{AS}$	Single Pulse Avalanche Energy <sup>④</sup>	1600	

### STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$BV_{DSS}$	Drain-Source Breakdown Voltage ( $V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu\text{A}$ )	500			Volts
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On-State Resistance <sup>②</sup> ( $V_{GS} = 10V, I_D = 23A$ )			0.100	Ohms
$I_{DSS}$	Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = 500V, V_{GS} = 0V$ )			100	$\mu\text{A}$
	Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = 400V, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$ )			500	
$I_{GSS}$	Gate-Source Leakage Current ( $V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$ )			$\pm 100$	nA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage ( $V_{DS} = V_{GS}, I_D = 2.5mA$ )	3		5	Volts



**CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

**DYNAMIC CHARACTERISTICS**

APT5010B2LL\_LLL

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
C <sub>iss</sub>	Input Capacitance	V <sub>GS</sub> = 0V V <sub>DS</sub> = 25V f = 1 MHz		4360		pF
C <sub>oss</sub>	Output Capacitance			895		
C <sub>rss</sub>	Reverse Transfer Capacitance			60		
Q <sub>g</sub>	Total Gate Charge ③	V <sub>GS</sub> = 10V V <sub>DD</sub> = 250V I <sub>D</sub> = 46A @ 25°C		95		nC
Q <sub>gs</sub>	Gate-Source Charge			24		
Q <sub>gd</sub>	Gate-Drain ("Miller") Charge			50		
t <sub>d(on)</sub>	Turn-on Delay Time	<b>RESISTIVE SWITCHING</b> V <sub>GS</sub> = 15V V <sub>DD</sub> = 250V I <sub>D</sub> = 46A @ 25°C R <sub>G</sub> = 0.6Ω		11		ns
t <sub>r</sub>	Rise Time			15		
t <sub>d(off)</sub>	Turn-off Delay Time			25		
t <sub>f</sub>	Fall Time			3		
E <sub>on</sub>	Turn-on Switching Energy ⑥	<b>INDUCTIVE SWITCHING @ 25°C</b> V <sub>DD</sub> = 333V, V <sub>GS</sub> = 15V I <sub>D</sub> = 46A, R <sub>G</sub> = 5Ω		545		μJ
E <sub>off</sub>	Turn-off Switching Energy			510		
E <sub>on</sub>	Turn-on Switching Energy ⑥	<b>INDUCTIVE SWITCHING @ 125°C</b> V <sub>DD</sub> = 333V, V <sub>GS</sub> = 15V I <sub>D</sub> = 46A, R <sub>G</sub> = 5Ω		845		
E <sub>off</sub>	Turn-off Switching Energy			595		

**SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS**

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
I <sub>S</sub>	Continuous Source Current (Body Diode)			46	Amps
I <sub>SM</sub>	Pulsed Source Current ① (Body Diode)			184	
V <sub>SD</sub>	Diode Forward Voltage ② (V <sub>GS</sub> = 0V, I <sub>S</sub> = -46A)			1.3	Volts
t <sub>rr</sub>	Reverse Recovery Time (I <sub>S</sub> = -46A, di <sub>S</sub> /dt = 100A/μs)		608		ns
Q <sub>rr</sub>	Reverse Recovery Charge (I <sub>S</sub> = -46A, di <sub>S</sub> /dt = 100A/μs)		11.0		μC
dv/dt	Peak Diode Recovery dv/dt ⑤			8	V/ns

**THERMAL CHARACTERISTICS**

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
R <sub>θJC</sub>	Junction to Case			0.25	°C/W
R <sub>θJA</sub>	Junction to Ambient			40	

- ① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
  - ② Pulse Test: Pulse width < 380 μs, Duty Cycle < 2%
  - ③ See MIL-STD-750 Method 3471
  - ④ Starting T<sub>J</sub> = +25°C, L = 1.51mH, R<sub>G</sub> = 25Ω, Peak I<sub>L</sub> = 46A
  - ⑤ dv/dt numbers reflect the limitations of the test circuit rather than the device itself. I<sub>S</sub> ≤ -I<sub>D</sub> 46A di/dt ≤ 700A/μs V<sub>R</sub> ≤ V<sub>DSS</sub> T<sub>J</sub> ≤ 150°C
  - ⑥ E<sub>on</sub> includes diode reverse recovery. See figures 18, 20.
- APT Reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

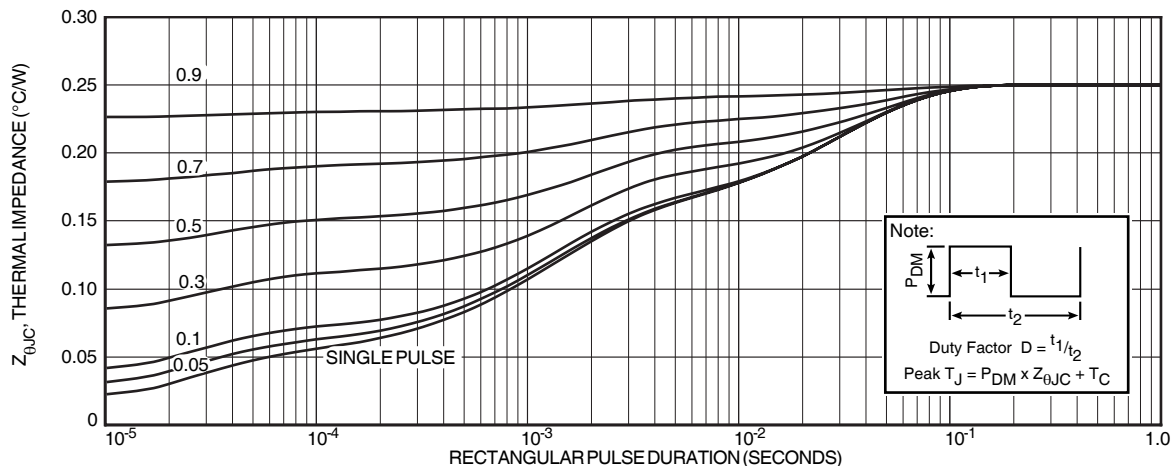


FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION

# Typical Performance Curves

APT5010B2LL\_LLL

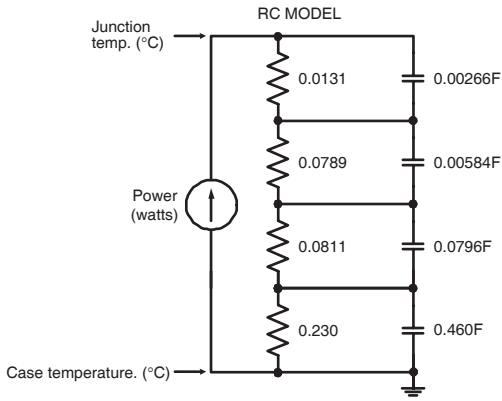


FIGURE 2, TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE MODEL

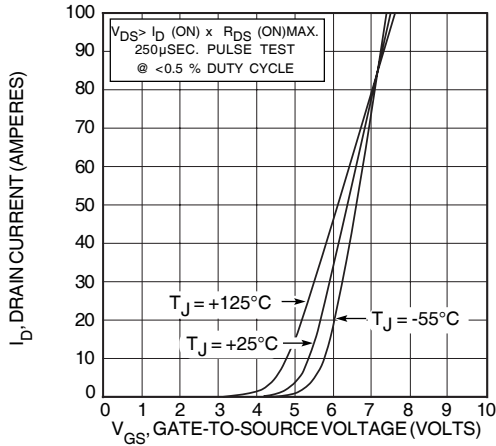


FIGURE 4, TRANSFER CHARACTERISTICS

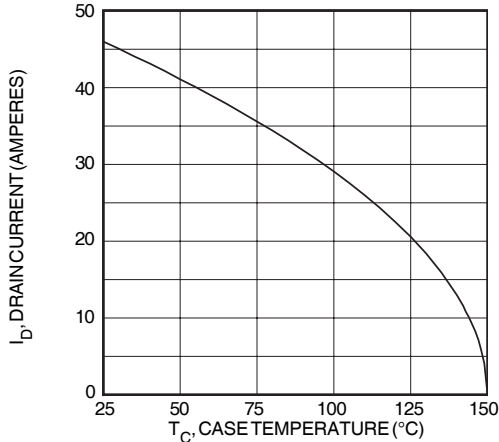


FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE

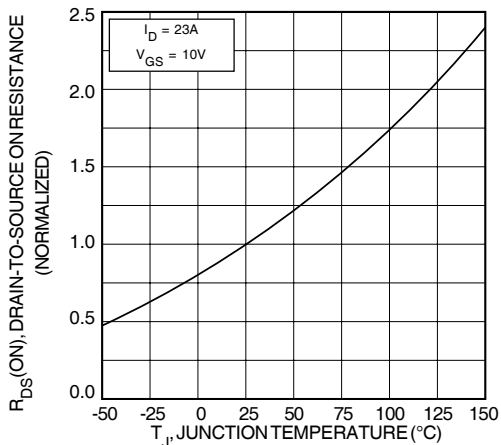


FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE

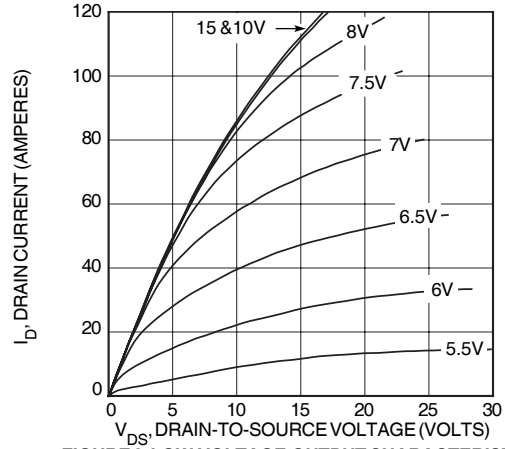


FIGURE 3, LOW VOLTAGE OUTPUT CHARACTERISTICS

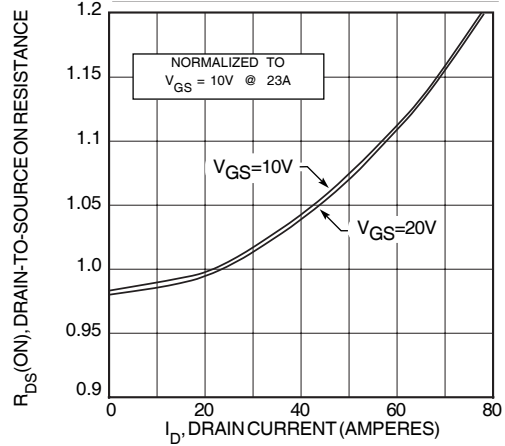


FIGURE 5,  $R_{DS(ON)}$  vs DRAIN CURRENT

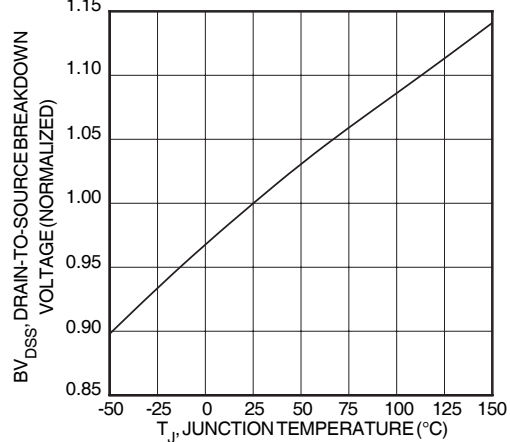


FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE

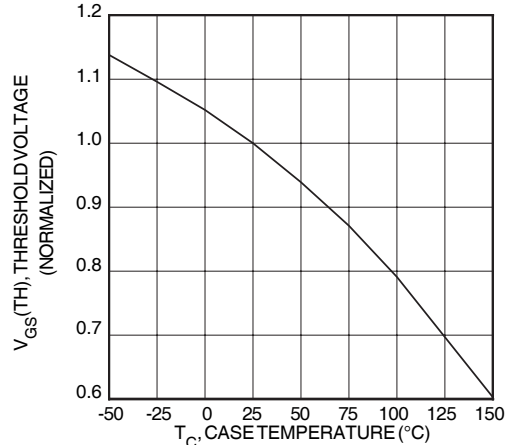


FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE

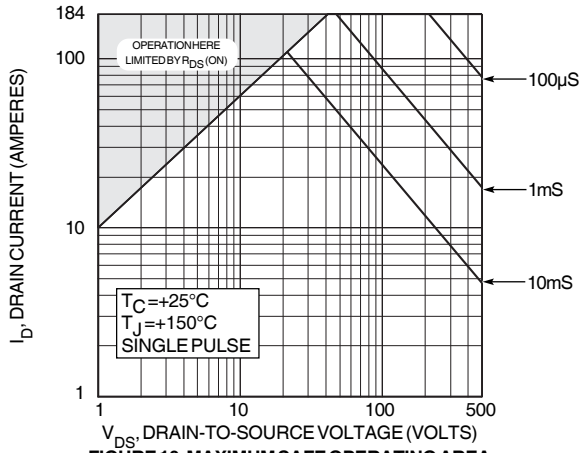


FIGURE 10, MAXIMUM SAFE OPERATING AREA

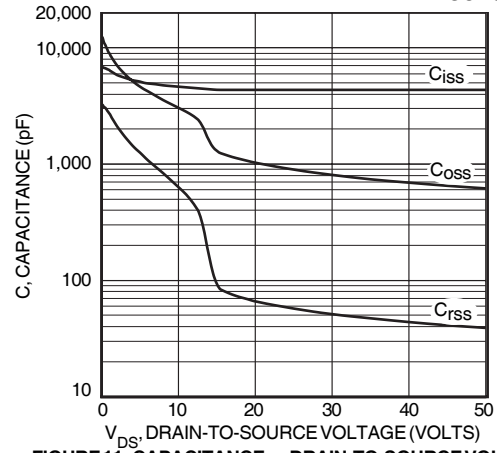


FIGURE 11, CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE

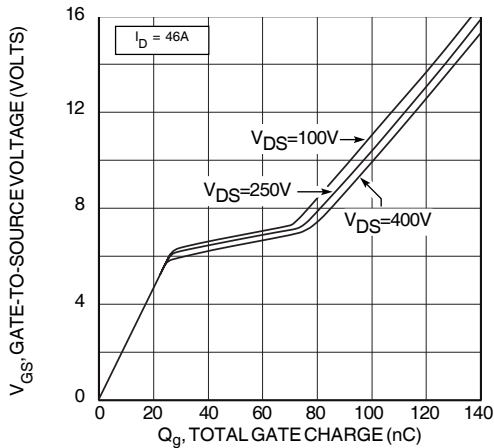


FIGURE 12, GATE CHARGES vs GATE-TO-SOURCE VOLTAGE

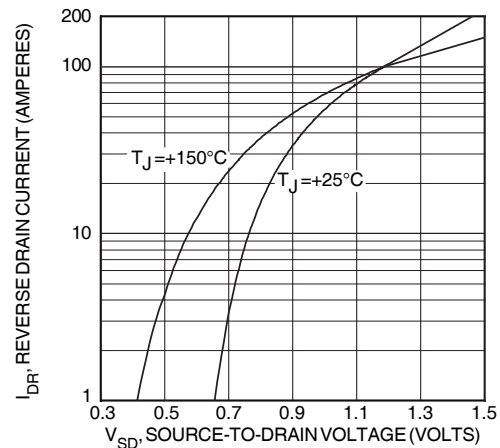


FIGURE 13, SOURCE-DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE

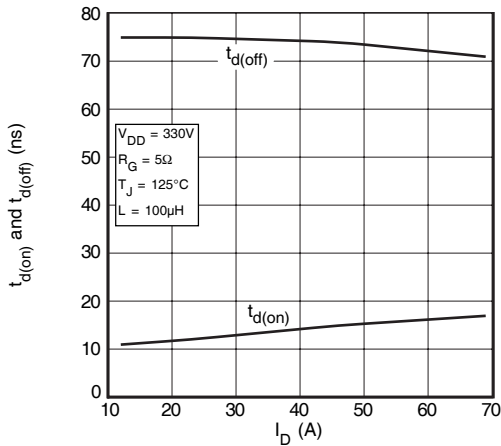


FIGURE 14, DELAY TIMES vs CURRENT

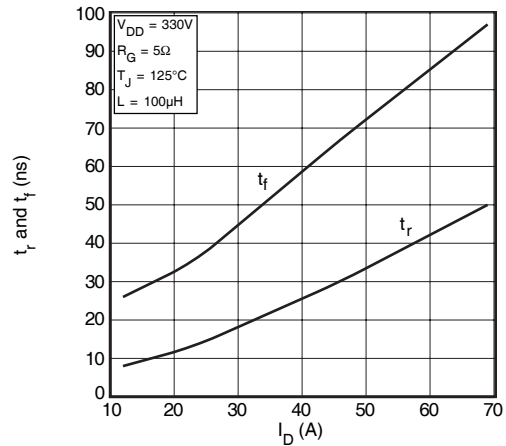


FIGURE 15, RISE AND FALL TIMES vs CURRENT

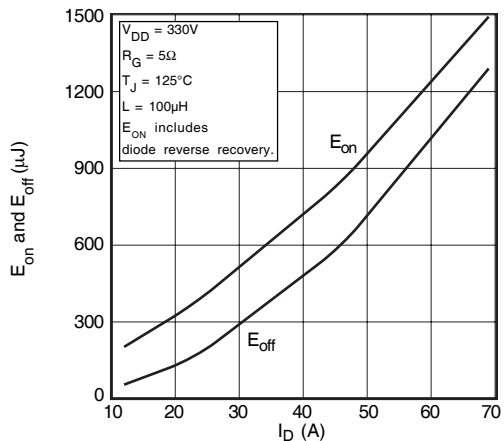


FIGURE 16, SWITCHING ENERGY vs CURRENT

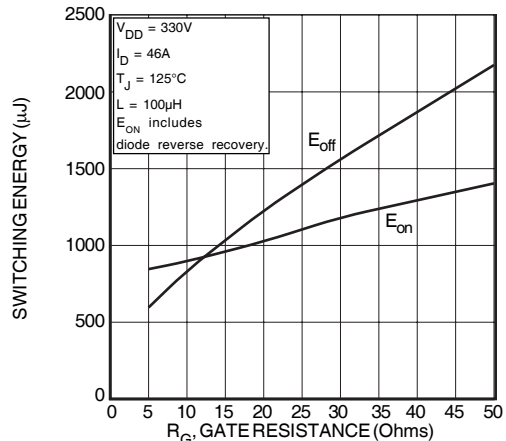


FIGURE 17, SWITCHING ENERGY vs. GATE RESISTANCE

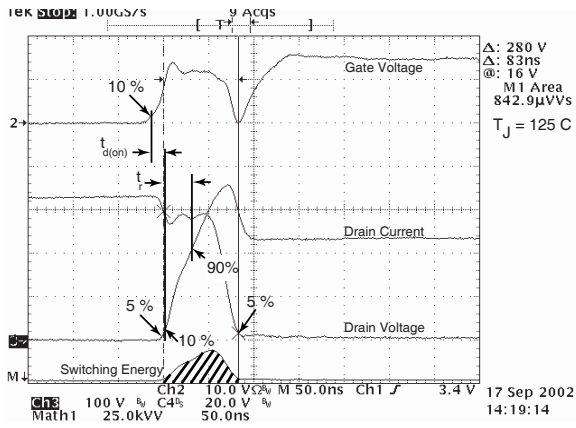


Figure 18, Turn-on Switching Waveforms and Definitions

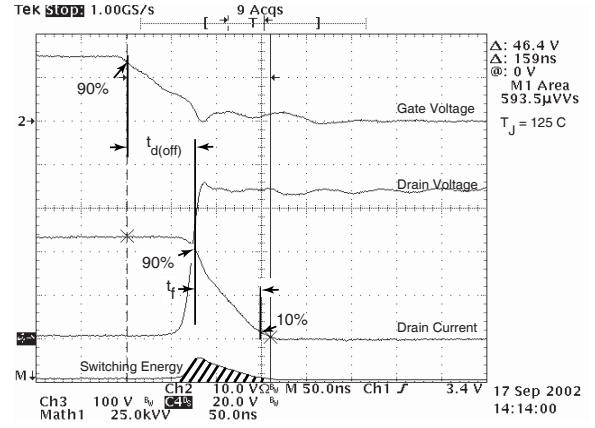


Figure 19, Turn-off Switching Waveforms and Definitions

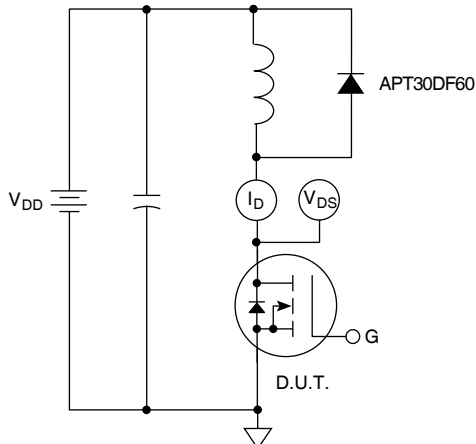
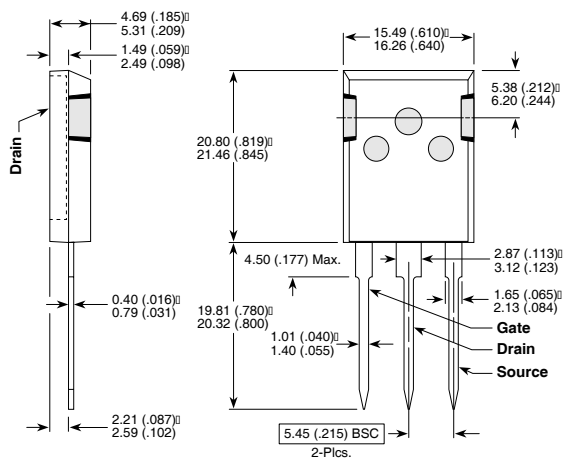


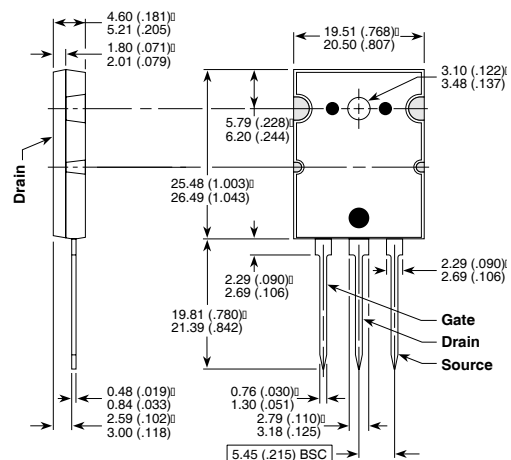
Figure 20, Inductive Switching Test Circuit

T-MAX™ (B2) Package Outline



These dimensions are equal to the TO-247 without the mounting hole.  
Dimensions in Millimeters and (Inches)

TO-264 (L) Package Outline



Dimensions in Millimeters and (Inches)

APT's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522

5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. US and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А